

Влияние электрических режимов
электроосаждения антимонида индия в
пористые матрицы АОА на состав и
микроструктуру образуемых нанопроводов

Лозовенко А. А. ¹,

Позняк А.А. ²,

Плиговка А. Н. ³,

Горох Г. Г. ⁴

2018

НИЧ, НИЛ 4.10, Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники

Ключевые слова: Нанопровода, электрохимическое осаждение,
анотимонид индия, пористые темплейты.

Аннотация:

Исследована микроструктура и состав нанопроводов из антимонида индия, сформированных методом электрохимического осаждения в пористые матрицы анодного оксида алюминия. Определены условия синтеза равномерных массивов нанопроводов и установлены зависимости состава структур от электрических режимов формирования.

Источник публикации: Наноструктуры в конденсированных средах: сборник научных статей. – 2018. – С. 111-118.